

中国科学院半导体研究所因公出访信息事前公示表

任务名称	赴韩国高丽大学GaN激光器材料缺陷与器件封装关联技术学术交流			
交流形式	学术访问			
拟出访人员名单	姓名	性别	所在部门	职务
	仲莉	女	中国科学院半导体研究所	研究员
出访国家(地区)	韩国		过境国家(地区)	
出访日期	离境日期	2026-02-11	抵境日期	2026-02-18
国（境）外邀请人姓名、单位	Inhwan Lee, Professor, Korea University（韩国高丽大学），Seoul 02841, Korea, Phone: +82-2-3290-3264			
出访理由	应韩国高丽大学（Korea University）邀请，半导体研究所仲莉研究员1人拟于2026年2月11日至18日赴韩国Korea University执行学术交流任务，拟在外停留8天。 高丽大学（Korea University）材料科学与工程系光电子材料实验室聚焦光电子材料与器件、半导体薄膜、GaN基结构深能级陷阱及器件性能关联等研究。实验室负责人Inhwan Lee教授曾担任三星先进技术研究院GaN激光器团队的负责人，并在耶鲁大学进行过学术访问，其研究兼具深厚的产业背景与学术洞察力。其所在院系是Korea University优势学科，依托韩国教育部科研基金等政府资助项目开展研究，具备扎实的官方科研支持背景与完善的实验平台。此前我方与Inhwan Lee教授团队无直接合作，但双方在光电子材料领域研究方向高度契合，均关注半导体器件性能提升的核心难题，存在极强的合作潜力。 仲莉研究员长期从事GaAs、InP基半导体激光器、探测器及GaN激光器封装技术研究，熟练掌握光电子器件设计、制备及封装工艺优化，发表多篇核心学术论文，具备独立开展跨学科合作研究的能力，在GaN激光器封装研究方向与Inhwan Lee教授团队的GaN基材料缺陷研究形成互补，尤其在封装环节发现的性能衰减问题，可借助材料缺陷表征与调控的技术优势溯源。出访期间，将参观光电子材料实验室并与Inhwan Lee教授团队研讨GaN基材料陷阱对封装可靠性的影响机制，分享我方在光电子器件研发及GaN封装工艺上的成果，探讨缺陷调控与封装优化的方案，预期产出缺陷-封装关联技术及GaN激光器封装优化初步方案，达成后续联合研究意向，推动双方学术论文合作发表。此次出访对本单位意义在于可引入GaN材料缺陷调控前沿技术，突破GaN激光器封装性能提升上的物理瓶颈，同时拓宽GaAs、InP基器件与宽禁带半导体材料的跨领域应用思路，搭建国际学术合作平台，为后续科研项目共研奠定基础。 此次出访的国际旅费和境外生活费用均由半导体所科研经费承担。在境外发生任何意外责任由半导体所承担。此次出访的相关信息已在半导体所的所务公开网上公示，且无异议。此次出访的人员信息已进行备案。			

出访日程安排	2026 年 2 月 11 日离京，2026 年 2 月 12-17 日学术研讨，2026 年 2 月 18 日返京。					
费用来源及开支预算明细	经费来源	人员所在单位支付				
	国际旅费	注册费	交通费	住宿费	伙食费/公杂费	其他
	10000人民币	0人民币	1000人民币	1260美元	560美元/280美元	480人民币